

# 2SC5619

高周波増幅用  
シリコン NPN エピタキシャル形

## 概要

2SC5619は、超小形外形樹脂封止形シリコンNPNエピタキシャル形トランジスタです。

高fTであり、また、コレクタ損失が大きく、ディスプレイモニター用等として最適です。

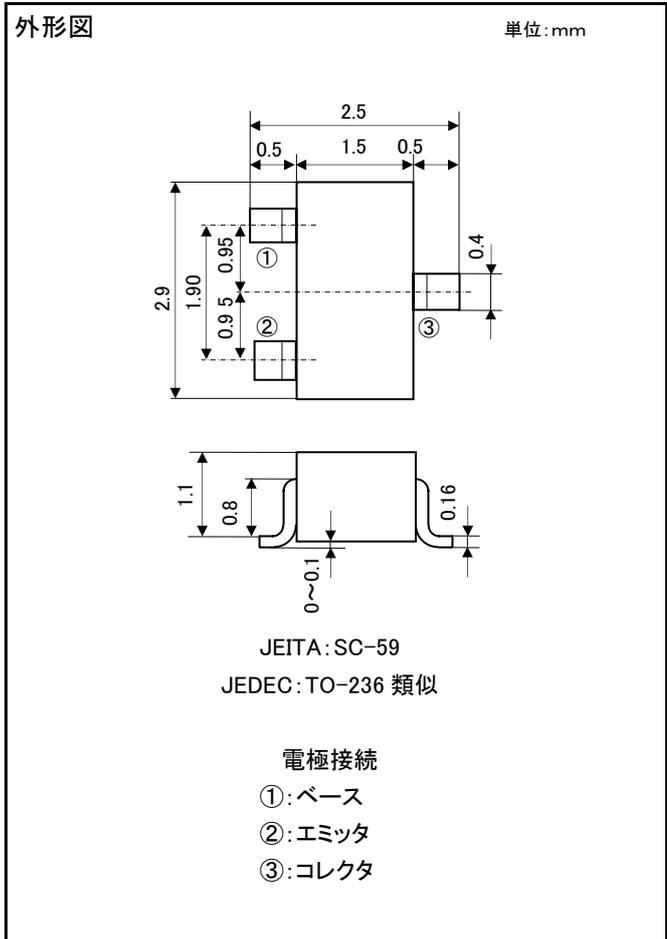
## 特長

- fTが高い fT=4.5GHz標準。
- Cobが小さい。Cob=1.0pF標準
- 超小形外形のため、セットの小型化、高密度実装が可能。

## 用途

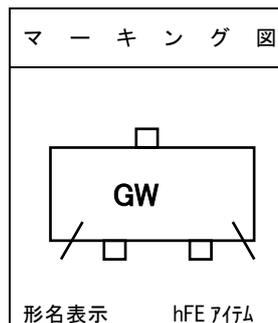
TV チューナー、通信機、携帯電話等

記号	項目	定格値	単位
V <sub>CB0</sub>	コレクタ・ベース間電圧	20	V
V <sub>EB0</sub>	エミッタ・ベース間電圧	3	V
V <sub>CE0</sub>	コレクタ・エミッタ間電圧	12	V
I <sub>C</sub>	コレクタ電流	50	mA
P <sub>C</sub>	コレクタ損失 (Ta=25°C)	150	mW
T <sub>j</sub>	接合部温度	+125	°C
T <sub>stg</sub>	保存温度	-125~ +125	°C



## 電気的特性 (Ta=25°C)

項目	記号	試験条件	特性値			単位
			最小	標準	最大	
コレクタ遮断電流	ICB0	V <sub>CB</sub> =10V, I <sub>E</sub> =0mA	-	-	0.5	μA
エミッタ遮断電流	IEB0	V <sub>EB</sub> =1V, I <sub>C</sub> =0mA	-	-	1.0	μA
直流電流増幅率	hFE	V <sub>CE</sub> =5V, I <sub>C</sub> =20mA	50	-	250	-
利得帯域幅積	fT	V <sub>CE</sub> =5V, I <sub>E</sub> =-20mA	-	4.5	-	GHz
コレクタ出力容量	Cob	V <sub>CB</sub> =5V, I <sub>E</sub> =0mA, f=1MHz	-	1.0	-	pF
電力利得	S <sub>21</sub>   <sub>2</sub>	V <sub>CB</sub> =5V, I <sub>C</sub> =20mA, f=1GHz	7.5	9.0	-	dB
雑音指数	NF	V <sub>CE</sub> =5V, I <sub>C</sub> =5mA, f=1GHz	-	1.5	-	dB

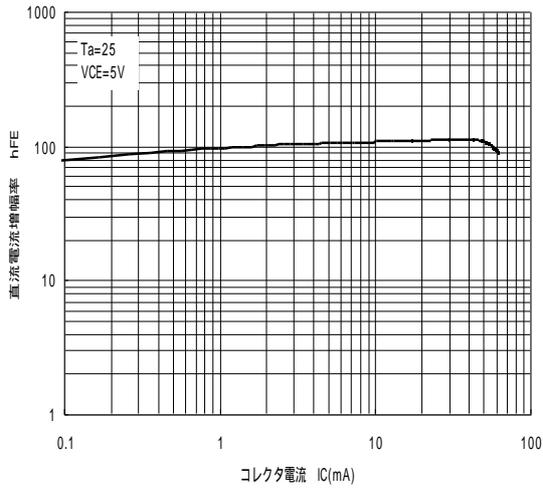


# 2SC5619

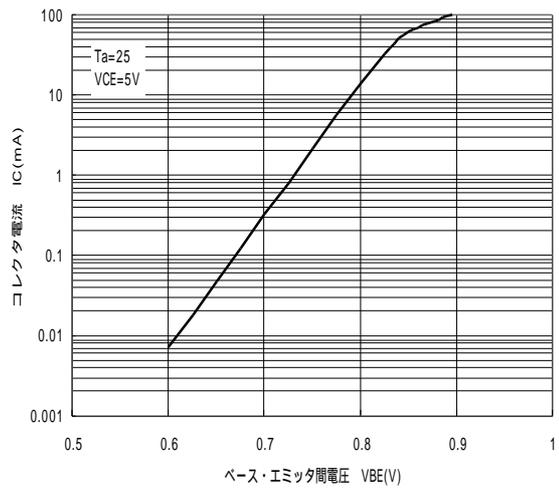
高周波増幅用

シリコンNPNエピタキシャル形

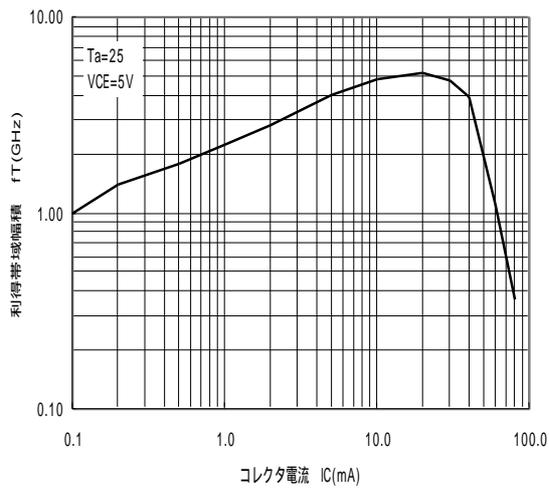
直流電流増幅率 - コレクタ電流特性



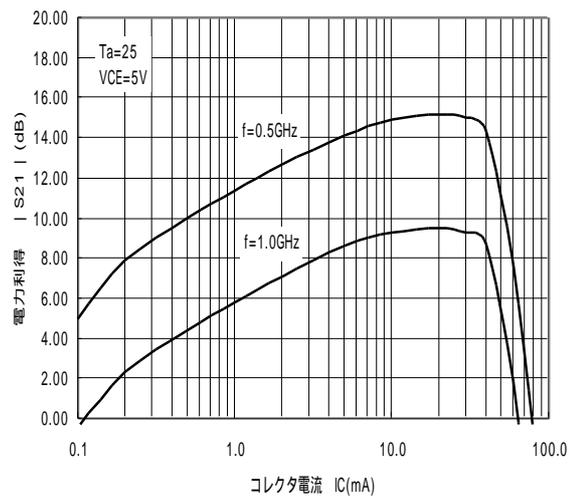
エミッタ接地伝達特性



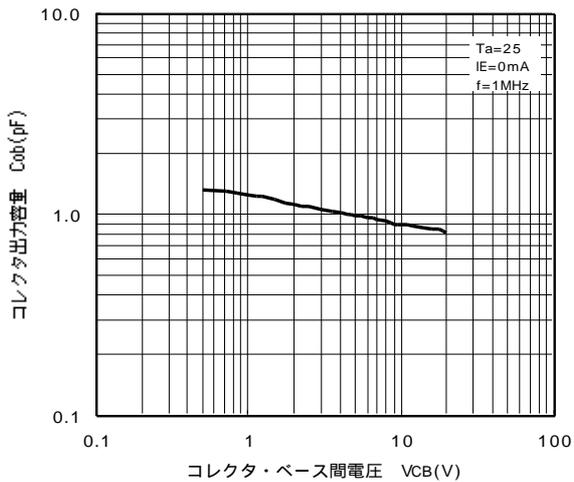
利得帯域幅積 - コレクタ電流特性



電力利得 - コレクタ電流特性



コレクタ出力容量 -  
コレクタ・ベース間電圧特性



雑音指数 - コレクタ電流特性

